



新闻稿

## 美光科技在博伊西建成新研发厂，进一步提升半导体研发能力

*新厂几近将美光在爱达荷的研发无尘室空间增加一倍*

美国爱达荷州博伊西，2017年8月14日——美光科技于今日在总部举办活动，庆祝扩建的新厂投入运转。这一工厂在公司研究未来具有突破性的全新内存和存储技术的过程中将扮演重要角色。在新设施配备完善后，美光在博伊西的研发专用无尘室的空间将增加近一倍，并将为公司整体研发能力的扩展提供重要支持。

这座位于博伊西的扩建研发厂对于美光开发新的半导体制造工艺和设计，满足该公司未来的存储和内存技术需求至关重要。在博伊西研发中心研发出的各种工艺随后会转至美光位于全球的12个大型制造工厂进行量产。

为纪念这一重要时刻，美光科技总裁兼首席执行官 Sanjay Mehrotra 和技术开发执行副总裁 Scott DeBoer 带领公众代表和政要参观了新工厂。

“打造世界上最先进的半导体是一个非常复杂的过程。” Mehrotra 说，“我们在爱达荷州有一支行业顶尖的科学家和工程师团队，他们所做的工作将会帮助塑造未来的技术、产品和解决方案，包括未来的手机、汽车和数据中心，并推动正在快速崛起的人工智能和大数据分析等新兴技术。今天，博伊西研发无尘室的落成标志着我们在博伊西的创新能力将得到大幅提升。”

该新的无尘工厂于2015年10月动工，旨在打造一个更大规模的无污染、可精确控制的研发环境，利用美光科技多年来的精深技术专长和创新能力，开发和制造先进的存储集成电路。建造该工厂需要24000立方码的混凝土，相当于让一辆混凝土车连续不间断地工作100天。这座先进的研发中心还使用了1000万磅钢筋，光是建筑物内就铺设了240英里长的线缆，这一长度足以连接到国际空间站。

博伊西的研发厂处于美光全球创新网络的核心位置，本次规模扩张将有助于加快新一代 DRAM、NAND 和新兴内存技术的开发速度。

DeBoer 特别指出，美光的尖端 DRAM 技术(1Ynm)已经从博伊西的研发中心转入美光位于日本广岛的制造工厂。在过去一年里，研发团队还在博伊西成功完成了64层3D NAND的开发过程，并将该技术从最初在博伊西的开发转入了美光在新加坡的工厂实现量产。

作为美光的全球技术开发中心，博伊西的研发厂正引领着诸如未来的 DRAM、3D XPoint™和 3D NAND 等新一代技术的开发。

### 美光科技有限公司

美光科技是创新存储解决方案领域的全球领军企业。通过旗下全球性品牌 Micron（美光）、Crucial®（英睿达）、Lexar®（雷克沙）和 Ballistix®（铂胜），美光丰富的高性能存储技术组合（包括 DRAM、NAND、NOR Flash 及 3D XPoint™存储）改变着世界使用信息的方式。凭借超过35年的技术领军地位，美光的存储解决方案让全球尖端计算、消费电子、企业级存储、数据中



心、移动产品、嵌入式产品和汽车应用成为可能。美光科技的普通股在纳斯达克上市交易，股票代码是 MU。

如需了解美光科技有限公司的更多信息，请访问 [micron.com](http://micron.com)。

*Micron 徽标和 Micron 标志是美光科技有限公司的商标。所有其他商标分别为其各自所有者所有。*

*请关注我们，加入美光科技社交平台！存储成就创新，我们在此交流所有关于存储和创新的话题：*

· 博客: <http://blog.sina.com.cn/microntechnology>



#### 媒体联系人:

美光科技有限公司

王佳晨 女士

电话: 021 - 6103 3343

E-mail: [joycewang@micron.com](mailto:joycewang@micron.com)

伟达（中国）公共关系顾问有限公司

张珏 女士

电话: 010 - 5861 7522

E-mail: [jue.zhang@hkstrategies.com](mailto:jue.zhang@hkstrategies.com)